

# キオクシア(Kioxia Holdings)徹底分析

## — 特許・技術・事業の包括的 IP ランドスケープ —

2026 年 7 月 13 日(改訂第 2 版)

Claude Fable 5

### 要旨

キオクシアは AI 推論向け NAND/SSD 需要を追い風に、2025 年度(2026 年 3 月期)に過去最高業績(売上収益 2 兆 3,376 億円、Non-GAAP 営業利益 8,762 億円)を達成し<sup>2,3</sup>、2026 年 6 月 12 日には時価総額 44 兆 3,627 億円でトヨタ自動車(43 兆 8,389 億円)を上回り日本企業首位に立った<sup>4</sup>。日経 Tech Foresight 記事(Patentfield 寄稿)による特許 3 軸分析が導いた「MRAM に経営の意思」という結論<sup>1</sup>は、SK hynix との共同研究成果(IEDM 2024 での 1S1M セル技術、ISSCC 2025 での 64Gbit 試作チップ)<sup>24,25</sup> という一次情報で部分的に裏付けられる。しかし、経営資源配分の実態を踏まえると、キオクシアの現在及び中期の中心は CBA を核とする 3D NAND、エンタープライズ SSD 及び AI 向けストレージソリューションであり、「MRAM に経営の意思」という表現には強い留保が必要である。

特許ポートフォリオは全世界で登録特許 14,000 件超(2024 年 12 月時点、キオクシア公表)<sup>16</sup>、米国特許付与件数は 2024 年に 719 件(IPO Patent 300 で 54 位)<sup>17</sup>。3 軸分析(ターゲット市場×技術テーマ×バリューチェーン)は、特許ポートフォリオを多面的に可視化する探索的フレームワークとして有用だが、分類の妥当性及び件数の再現性は別途検証を要する。MRAM 向け 416 件などの個別数値は Patentfield 独自アルゴリズムの出力であり、本分析では独立検証できていない。

IP ランドスケープ実務上の要点として、キオクシアの特許網の真の強みは 3D NAND 製造プロセス/セル構造と CBA ウエハーボンディングにある。MRAM 及び OCTRAM は将来のメモリ階層変化に備えた重要な研究開発オプションであり、大容量試作・技術実証段階まで到達しているが、量産ロードマップや設備投資は公表されておらず、現段階で「次世代主力事業」と評価するのは早い。もっとも、継続的な特許蓄積と 64Gbit 級試作は、単なる探索研究を超えた技術投資を示している。足元では Monolithic 3D による ITC 337 条調査(337-TA-1492、2026 年 3 月 26 日開始<sup>28</sup>、第 2 調査が同年 6 月 10 日開始<sup>29</sup>)という知財リスクも顕在化している。

## 1. 事業・財務の現状

以下は一次情報および報道により確認された事実である。

- **2025 年度通期決算(2026 年 5 月 15 日発表):**売上収益 2 兆 3,376 億円(前期比 37.0%増)、Non-GAAP 営業利益 8,762 億円(同 93.4%増)、親会社株主帰属当期純利益 5,545 億円で 2 期連続の過去最高<sup>3</sup>。EE Times Japan によれば、この営業利益は東芝メモリ時代を含む過去最高(2018 年 3 月期の 4,791 億円)を 8 年ぶりに更新し、売上高営業利益率は 37.5%に達した<sup>2</sup>。
- **第 4 四半期(2026 年 1~3 月期):**売上高 1 兆 29 億円(前年同期比 188.9%増)、Non-GAAP 営業利益 5,991 億円(同 15.9 倍)。単一四半期の営業利益が 2024 年度通期(4,530 億円)を上回った<sup>2</sup>。
- **2027 年 3 月期第 1 四半期ガイダンス:**売上高 1 兆 7,500 億円、Non-GAAP 営業利益 1 兆 3,000 億円(営業利益率約 74%)という製造業として異例の水準<sup>2</sup>。
- **株価・時価総額:**2024 年 12 月 18 日に東証プライム上場(初値 1,601 円、時価総額約 8,630 億円)。2026 年 6 月 12 日終値 8 万 1,200 円で時価総額 44 兆 3,627 億円となりトヨタ自動車を超え日本首位<sup>4</sup>。同終値は IPO 売価格 1,455 円の約 56 倍に相当する。その後、株価は一時 10 万円を超えた局面も報道されている<sup>19</sup>。
- **株主構成:**2025 年 9 月末時点で東芝 27.25%、BCPE Pangea Cayman, L.P.(ベイン系)22.00%が上位。2026 年に入り両者は段階的売却を進め、東芝は 2026 年 3 月 17 日時点で 19.80%に低下。ベインは全保有株の売却を進めたと幹部発言ベースで報道<sup>5</sup>。SK hynix はベイン主導コンソーシアムへの出資・転換可能証券等を通じてキオクシアに経済的利害を有してきたが、直接・間接の持分比率は証券の転換及び売却状況により変動するため、言及の際は基準日を付す必要がある(分析)。
- **設備投資:**2026 年 3 月期は 2,837 億円。CFO 河村芳彦氏は 2026~2028 年度の 3 年間で年平均約 4,700 億円の設備投資を計画し、「スーパーサイクルに入っていく」と表現<sup>2</sup>。
- **DRAM 調達:**2026 年 3 月、台湾 Nanya Technology に 156 億台湾ドル(約 774 億円)出資、長期供給契約を締結。

### 1.1 解釈:AI 相場の最大の勝者、しかし「NAND 一本足」のリスク

(以下は分析・評価)生成 AI の主戦場が「学習」から「推論」へ移行する中で、大容量・高速ストレージ需要の爆発を最も鮮やかに捉えたのがキオクシアである。用途別では「SSD&ストレージ」向けが売上全体の 58.3%(1 兆 3,626 億円、前年比 37.5%増)を占める<sup>2</sup>。ただし、DRAM・HBM・

NAND・eSSDまでAIメモリ需要を総取りできるSKハイニックスと異なり、キオクシアはNAND一本足であり、上昇局面では最大のレバレッジとなる一方、シリコンサイクル反転時には最も急激な落ち込みに直面する構造にある。2025年11月の第2四半期決算では最終利益が前年同期比66.5%減となり株価が急落した局面もあった。2026年6月2日のInvestor Dayでは累進配当の「開始」表明にとどまり具体額・通期予想が示されず、時間外取引で「材料出尽くし」の下落となった<sup>6</sup>。

## 2. 技術・製品戦略

BiCS FLASHの世代別性能値は、比較対象(世代・容量・製品)が世代ごとに異なるため、以下では各公式発表の比較基準を明記する。

- **BiCS FLASH 第8世代:**218層とCBA(CMOS directly Bonded to Array)技術を採用し量産中。最大3.6Gb/sのNANDインターフェース速度を実現し、ビット密度向上、書き込み性能向上及び電力効率改善を達成した<sup>7</sup>。2026年度末にはNAND出荷量の約80%が第8世代となる見込み<sup>2</sup>。
- **第9世代(2025年7月サンプル出荷開始、量産は2025年度中):**第5世代技術ベースの120層メモリセル技術+最新CMOS技術の組合せ。同容量の第6世代512Gb TLC製品比で、書き込み性能61%向上、読み出し性能12%向上、電力効率は書き込み時36%・読み出し時27%改善、ビット密度8%向上。Toggle DDR6.0により通常仕様で3.6Gb/s、4.8Gb/sまでの動作も検証済み<sup>8</sup>。投資コストを抑えつつ高性能を実現する製品群と位置づけ。
- **第10世代(2026年7月3日に1Tb TLC製品のサンプル出荷を開始):**北上工場(岩手県北上市)第2製造棟の最新設備で生産を開始。CBAとOn Pitch Select Gate Drain(OPS)技術を活用し、NANDインターフェース速度は第8世代比33%向上の4.8Gb/s。積層数332層と平面方向の高密度化によりビット密度は同59%向上。電力効率は書き込み時18%・読み出し時30%改善(いずれも第8世代比)<sup>9</sup>。「400層超の高積層化」ではなく「332層+2次元シュリンク」を選択し、電力・信頼性重視の割り切り戦略を明言している<sup>20</sup>。
- **CBAの先行性:**2023年から量産適用しており、量産適用において競合に2~4年程度先行しているとの評価がある<sup>19</sup>。ただし各社でハイブリッドボンディングの技術定義・量産認定時期・適用製品が異なるため、先行幅の断定には留意が必要(分析)。

- **エンタープライズ SSD:LC9 シリーズ**は業界初の 245.76TB NVMe SSD。第 8 世代 QLC の 32 ダイ積層+CBA で 8TB/154 ボール BGA パッケージを実現<sup>10</sup>。FMS 2025 で「Best of Show」受賞、Dell Technologies が採用<sup>11</sup>。
- **AI 向けソフトウェア**:KIOXIA AiSAQ(SSD 上にベクトル DB 要素を格納し DRAM 依存を低減、RAG 高速化)、NVIDIA の GPU 接続ストレージ構想・cuVS 連携。
- **HBF(High Bandwidth Flash)**:2025 年 8 月、NEDO プロジェクトの下で 5TB・64GB/s・40W 未満のフラッシュメモリモジュール試作成功と報じられた<sup>12</sup>(二次情報。数値は NEDO 又はキオクシアの成果発表・学会論文での確認を要する)。HBF 標準化の OCP ワークストリームは SanDisk と SK hynix が 2026 年 2 月 25 日に発足させたが<sup>13</sup>、公表された設立メンバーには現時点でキオクシアの記載を確認できない。

## 2.1 SanDisk(旧 Western Digital)との関係

キオクシアと SanDisk は、25 年以上にわたり複数の製造合弁会社(総称 Flash Ventures)を通じて四日市工場(7 棟)・北上工場(2 棟)の設備投資及び生産を共同で行っている(各 JV 会社の持分・議決権比率は会社ごと・基準日ごとに確認を要する)。2024 年 2 月に JV は最大 1,500 億円の政府補助金承認を受けた<sup>14</sup>。2025 年 2 月に SanDisk が Western Digital から分社・上場。2026 年 1 月 29 日、四日市・北上の JV 契約を 2029 年末から 2034 年末まで 5 年延長し、SanDisk は製造サービス対価として 11.65 億ドルを 2026~2029 年に分割支払いする<sup>15</sup>。第 10 世代(332 層)は SanDisk との共同開発である<sup>20</sup>。キオクシア・WD/SanDisk 統合議論は過去に浮上したが SK hynix 側が反対した経緯が報じられており、現時点で正式な統合合意は確認されていない。

## 3. 特許ポートフォリオの検証

- **総登録特許**:全世界 14,000 件超(2024 年 12 月時点、キオクシア公表)。FY2024 研究開発費 1,328 億円。Clarivate Top 100 Global Innovators 2025 受賞<sup>16</sup>。
- **米国特許付与**:IPO Patent 300 によれば、2024 年 719 件(54 位、前年比+5%)、2023 年 687 件(57 位)、2021 年 672 件(66 位)<sup>17</sup>。2020 年度から米国出願件数が日本出願を上回った(同社知的財産部長・初見通仁氏、MONOist 2022)。
- **共同名義案件**:第三者データベース上、2021~2026 年の米国出願に SK hynix との共同名義案件が少数(12 件)確認される<sup>18</sup>。ただし、公開公報か登録特許か、共同出願か共同権利者か、同一ファミリーの重複か等が未検証であり、名寄せ及びファミリー単位での検証を要する。

- **R&D 組織**: 先端技術研究所(2024 年 4 月にメモリ技術研究所から改組、社長直轄)、開発センター、事業部の三層構造。IMEC・Stanford とのオープンイノベーション。東芝メモリ期には約 7,500 パテントファミリー、18 特許庁で 18,000 件超、発明者 2,000 名超(InQuartik 分析)<sup>21</sup>。

### 3.1 日経記事「3 軸分析」の批判的評価

日経 Tech Foresight 記事(近藤和樹氏、Patentfield 寄稿、2026 年 7 月 6 日)<sup>1</sup>は、2015 年以降の日本出願を対象にターゲット市場・技術テーマ・バリューチェーンの 3 軸で整理したものである。この枠組みは、特許ポートフォリオを事業文脈で多面的に可視化する探索的フレームワークとして有用である。ただし、①一つの特許の複数市場への重複分類の有無、②出願件数か公開件数か、③分割出願の重複処理、④旧東芝名義案件の承継範囲、⑤AI 分類の学習データ・信頼度、⑥ファミリー統合の有無、⑦日本出願のみでグローバルな経営意思を判断できるか——といった方法論上の論点が開示されておらず、分類の妥当性及び件数の再現性は別途検証を要する(分析)。

内容面では、半導体製造・検査ソリューションが最多(2,519 件)、次いでデータセンター・エンタープライズ(1,560 件)という配分は、垂直統合メーカーとして製造装置・プロセスの下位レイヤーに厚い特許網を築くという実態と整合する。データセンター市場で「メモリコントローラ・システム制御」(756 件)、「システムアーキテクチャ」(1,004 件)が「3D NAND 構造・セル技術」(338 件)を上回るという指摘も、AiSAQ や HBF のようなソリューション志向の投資、「上位レイヤーの高付加価値ソリューションで稼ぐ意思」と符合する。

一方、記事の結論「MRAM に経営の意思」には批判的検証が必要である。次世代メモリ素材特許で MRAM 向け 416 件が最多という数値は、Patentfield 独自アルゴリズムの出力であり(同社は情報の正確性・完全性を保証しない旨を明記)、本分析では独立した再現・検証ができなかった。定性的には、SK hynix との共同研究(後述)が MRAM への継続投資を裏付けるが、現在及び中期の収益・投資の中心は明確に 3D NAND/SSD である。なお、同媒体では 2024 年 12 月にも「キオクシア上場へ、活路は MRAM」との記事が掲載されており<sup>22</sup>、MRAM に焦点を当てた関連記事が複数あることから、分析上の着眼点が MRAM に寄っている可能性には留意したい。したがって「NAND フラッシュに次ぐ次世代主力として MRAM に最も厚くリソースを投下」という含意は、特許出願件数の相対比較としては成立しうるが、事業インパクトの観点では過大評価のリスクがある(以上、分析・推測を含む)。

## 4. MRAM・次世代メモリの実態

- **クロスポイント MRAM(SK hynix と共同、SCM 用途想定):**2016 年に 4Gbit STT-MRAM を共同開発(IEDM 2016)。IEDM 2024 で 64Gbit クロスポイント MRAM を構成する 1S1M セル技術(セルハーフピッチ 20.5nm、MTJ 径 20nm、セル面積  $0.001681\mu\text{m}^2$ )を発表し<sup>24,25</sup>、ISSCC 2025 で 64Gbit 試作チップと新規読み出し方式を発表した。
- **高密度 STT-MRAM 向け MTJ 研究(別テーマ):**IEDM 2023 で 14nm AccelHR-MTJ(10 年超のデータ保持と 5ns 高速書き込みの同時実現)を発表<sup>23</sup>。上記クロスポイント MRAM とは技術目的・セル構成が異なる研究テーマである。
- **その他の次世代メモリ:**OCTRAM(酸化物半導体チャネル DRAM、Nanya と共同、IEDM 2024)<sup>24</sup>、ReRAM(2013 年に SanDisk と 32Gbit ReRAM)、FeFET/FeRAM、水平セル積層 3D NAND 構造(IEDM 2024)等も研究。
- **MRAM 市場の競争:**市場調査(Dataintelo)によれば組み込み MRAM 市場は 2025 年に約 18 億ドル、うち STT-MRAM が 62.4%。Everspin が唯一の標準品 merchant supplier として首位、Samsung・TSMC・GlobalFoundries がファウンドリ層の主要プレーヤー<sup>26</sup>(推計値、機関により差異あり)。キオクシアは量産 MRAM 製品を持たない。

(分析)キオクシアの MRAM は、64Gbit 試作チップまで到達した大容量試作・技術実証段階にあるが、量産製品化のロードマップは公表されていない。「純粋な基礎研究」でも「次世代主力」でもなく、SCM(DRAM と NAND の中間層)市場が立ち上がった場合に備えた重要な研究開発オプションと位置づけるのが正確である。業界全体として、MRAM・PCM・ReRAM・FeRAM は「ストレージクラスメモリ」として DRAM/NAND 代替を狙ったが、容量・スケーリング・コストで両者を置き換えられず、組み込み用途などニッチにとどまっており、Intel/Micron の 3D XPoint(Optane)は撤退済みである。この文脈で、キオクシアの「次世代メモリは研究開発として広く張りつつ、事業投資は NAND に集中」という選択と集中は合理的であり、MRAM を SK hynix と、OCTRAM を Nanya と組む「パートナー分散」も単独での巨額投資リスクを避ける堅実な戦略といえる。

## 5. 知財リスク・訴訟動向

- **MonolithIC 3D 対キオクシア・SK hynix(ITC 337 条調査):**3D 集積技術の特許保有・ライセンス事業者である MonolithIC 3D Inc.(米テキサス州 Allen)が 2026 年 2 月 17 日に ITC へ 337 条申立(2 月 25 日・3 月 16 日補正)。事件名は「Certain NAND and DRAM Memory Chips」であり、米特許 7 件の侵害を主張(キオクシアについては主に NAND、SK hynix については DRAM 及び NAND が対象)。ITC は 2026 年 3 月 26 日に調査開始を決定(337-TA-1492、完了目標

2027 年 8 月 30 日)<sup>27,28</sup>。申立人は限定的排除命令・排除措置命令を求めているが、調査開始は請求の実体的妥当性を認定したものではない。

- **第 2 調査:**同社は 2026 年 5 月 11 日に追加 5 特許で第 2 の申立(5 月 28 日・6 月 1 日補正)を行い、ITC は 6 月 10 日に第 2 調査の開始を決定(被申立人はキオクシア HD、キオクシア株式会社、KIOXIA America 等のグループ各社及び SK hynix 各社。完了目標日は未設定)<sup>27,29</sup>。第 2 調査の調査番号・対象特許の詳細は USITC 公式データベース(EDIS)での確認を要する。
- **YMTC 関連:**YMTC は Micron を 3D NAND 特許(96/128/176/232 層品)で複数提訴しており<sup>30</sup>、3D NAND 分野における訴訟環境の変化としてモニタリングを要する。ただし、キオクシアが被告となる直接の YMTC 訴訟は確認できず、現時点でキオクシア製品による特定特許の充足性を確認したものではない。

## 6. IP ランドスケープ実務への示唆(提言)

**短期(~3 か月):**日経/Patentfield 数値の「相対指標」としての活用。3 軸分析の枠組みは有用だが、MRAM 416 件・PCM/ReRAM 250 件・FeFET/FeRAM 45 件等の絶対数は Patentfield 固有分類に依存する。J-PlatPat、Espacenet 等を用い、H10B41(フラッシュメモリ)、H10B53(強誘電体メモリ)、H10N50(磁気抵抗・スピントロニクス素子)等の CPC デバイス分類と、G11C 系の回路・読み書き制御分類を組み合わせた独自クロス集計により、記事数値を検証・補正することを推奨する。CPC/IPC は分類改正・再分類が進んでいるため、旧 IPC のみで固定的な対応表を作ることは避け、ファミリー単位・法的ステータス(登録/係属/消滅)別の再集計により、「出願件数」が実際に権利化・維持されているかも判別すべきである。

**中期(3~12 か月):**CBA・ウェハーボンディング特許網の深掘り。キオクシアの真の防衛線は CBA と 32 ダイ積層パッケージにある。この領域のコア特許・主要発明者クラスたと、Samsung/SK hynix/Micron の対応特許を突き合わせ、クロスライセンス上の交渉力を評価すべきである。SanDisk との共同発明(Flash Ventures 由来の共有特許)の帰属・持分整理も重要となる。並行して、MonolithIC 3D の ITC 調査(第 1・第 2)の進展をモニタリングし、3D 積層特許の有効性・回避設計の要否を見極める。

**長期(12 か月~):**MRAM/SCM のオプション価値評価。MRAM は「次世代主力」ではなく「SCM 市場が立ち上がった場合のリアルオプション」と位置づけるのが妥当である。SK hynix との共同研究の学会発表(IEDM/ISSCC/VLSI)を継続追跡し、64Gbit 試作から実用容量・歩留まりへの進展が

閾値を超えた段階で評価を格上げすべきである。

**判断を変える閾値:**(a) キオクシアが MRAM の製品化ロードマップ(サンプル出荷時期・量産計画)を公式に示した場合は MRAM の事業的重要性評価を格上げ、(b) NAND ASP が 2 四半期連続で二桁下落した場合は「一本足」リスクの顕在化と判断、(c) ITC 調査で違反認定・排除命令に向けた実体判断が進んだ場合は知財リスクを再評価、(d) 第 10 世代(332 層)の量産歩留まりが計画通りに立ち上がれば、CBA 先行優位が中期の価格決定力として定着したと評価する。

## 7. 留意事項(エピステミックな留保)

- Patentfield 3 軸分析の個別数値(市場別・技術テーマ別・バリューチェーン別・次世代メモリ素材別の件数)は同社独自アルゴリズムの出力であり、独立検証できていない。本レポートではこれらを「相対的傾向を示す参考値」として扱い、絶対数として依拠していない。特に MRAM 416 件は他の公開情報源で再現・確認できなかった。
- 日経記事本文はペイウォールにより全文の直接取得ができず、要点は提供資料およびダイジェストページに依拠している。
- BiCS FLASH の性能値は、世代・容量・比較対象製品(第 9 世代は第 6 世代 512Gb TLC 比、第 10 世代は第 8 世代比)が発表ごとに異なる。本文では各公式発表の比較基準を明記したが、世代間の直接比較には注意を要する。
- Non-GAAP 指標は IFRS 会計項目ではなく、監査対象外の社内指標である。SK ハイニックス(K-IFRS)等との単純比較は会計基準・決算期・通貨の違いに注意を要する。
- 株主構成・持分比率は基準日により変動が大きい。ベインの「全株売却」は幹部発言ベースの報道であり、確定的な最終持分は要確認。SK hynix の間接持分も証券の転換・売却状況により変動する。
- 時価総額・株価倍率等は報道時点のものであり、メモリ市況の変動で大きく変わりうる。証券会社の目標株価は予測であり事実ではない。
- MRAM 市場規模・シェアは市場調査会社の推計であり、機関により差がある(組み込み MRAM 2025 年で 13.3 億~18 億ドル等)。
- HBF 試作の性能値(5TB・64GB/s・40W 未満)は二次報道ベースであり、NEDO 又はキオクシアの成果発表・学会論文での確認を要する。「OCP ワークストリーム設立メンバーにキオクシアの記載がない」ことは「参加していない」ことと同義ではない(非公開参加・後日参加等の可能性は排除できない)。

## 参考文献

- [1] 近藤和樹(Patentfield 寄稿)「キオクシアの特許を3軸分析 MRAM に『経営の意思』透ける」攻めの武器は AI×知財(2)、NIKKEI Tech Foresight、2026 年 7 月 6 日。<https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC2309H0T20C26A6000000>
- [2] 福田昭「キオクシアの 2026 年 3 月期決算、8 年ぶりに営業利益が過去最高を更新」ストレージ通信 (315)、EE Times Japan、2026 年 6 月 8 日。  
<https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2606/08/news033.html>
- [3] キオクシアホールディングス「2026 年 3 月期 通期決算」2026 年 5 月 15 日発表(決算短信・決算説明資料)。
- [4] 朝日新聞「キオクシア時価総額、トヨタ超え日本首位に」2026 年 6 月 12 日報道。
- [5] Investing.com「ベインがキオクシアの全保有株を売却、幹部がブルームバーグに明かす」2026 年。  
<https://jp.investing.com/news/stock-market-news/article-1597102> ※幹部発言ベースの報道
- [6] 株帳「キオクシア(285A)Investor Day 2026 年 6 月 2 日 内容まとめ」。  
<https://kabucho.com/articles/kioxia-285a-investor-day-2026-06-02> ※二次情報
- [7] KIOXIA「High-density 3D flash memory using high-precision wafer bonding brings new value to storage」(CBA 技術解説)。<https://www.kioxia.com/en-jp/business/topics/bics-cba-202407.html>
- [8] キオクシア「第 9 世代 BiCS FLASH 512Gb TLC 製品のサンプル出荷について」2025 年 7 月 25 日。  
<https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2025/20250725-1.html>
- [9] キオクシア「高性能、大容量、低消費電力を実現した第 10 世代 BiCS FLASH のサンプル出荷を開始」2026 年 7 月 3 日。<https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2026/20260703-1.html>
- [10] KIOXIA America「KIOXIA Announces Industry's First 245.76 TB NVMe SSD Built for the Demands of Generative AI Environments」2025 年 7 月 21 日。<https://americas.kioxia.com/en-us/business/news/2025/ssd-20250721-1.html>
- [11] KIOXIA America「KIOXIA LC9 Series 245.76 TB Enterprise SSD ... Named 'Best of Show' at FMS 2025」2025 年 8 月 5 日。<https://americas.kioxia.com/en-us/business/news/2025/ssd-20250805-1.html>
- [12] TechPowerUp「News Posts matching 'High-Bandwidth Flash」(キオクシア NEDO プロジェクト試作報道、2025 年 8 月)。<https://www.techpowerup.com/news-tags/High-Bandwidth%20Flash> ※二次情報、一次確認要
- [13] VideoCardz「SK hynix and Sandisk launch OCP workstream to standardize High-Bandwidth Flash memory」2026 年 2 月。<https://videocardz.com/newz/sk-hynix-and-sandisk-launch-ocp-workstream-to-standardize-high-bandwidth-flash-memory> ※二次情報
- [14] Western Digital「Kioxia and Western Digital's Joint Venture To Receive Up To 150 Billion Yen Government Subsidy」2024 年 2 月 6 日。<https://www.westerndigital.com/company/newsroom/press-releases/2024/2024-02-06-kioxia-and-western-digitals-joint-venture-to-receive-up-to-150-billion-yen-government-subsidy>

- [15] Kioxia/Sandisk 「Kioxia and Sandisk Extend Yokkaichi Joint Venture Agreement Through 2034」 2026 年 1 月 29 日。 <https://apac.kioxia.com/en-apac/about/news/2026/20260130-1.html>
- [16] キオクシアホールディングス「価値創出の基盤」(サステナビリティ:登録特許 14,000 件超、Clarivate Top 100 受賞)。 <https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/sustainability/materiality/foundation.html>
- [17] Intellectual Property Owners Association 「Top 300 Organizations Granted U.S. Patents in 2024」 2025 年 1 月。 <https://ipo.org/wp-content/uploads/2025/01/2024-Top-300-Patent-Owners-List.pdf>
- [18] patent-i.com 「KIOXIA CORPORATION Patent Analysis Report (US Patent)」 。 [https://patent-i.com/report/us\\_en/applicant/KIOXIA%20CORPORATION/](https://patent-i.com/report/us_en/applicant/KIOXIA%20CORPORATION/) ※第三者集計、名寄せ・ファミリー重複未検証
- [19] 「時価総額 45 兆円に キオクシア復活劇を支えた NAND 戦略」 EE Times Japan、2026 年 7 月 10 日。 <https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2607/10/news073.html>
- [20] innovaTopia 「Kioxia BiCS10 始動、332 層 NAND を北上工場で」 2026 年 7 月。 <https://innovatopia.jp/semiconductor/semiconductornews/112328/> ※二次情報
- [21] InQuartik 「Toshiba Memory (Kioxia) Patent Deployment Analysis: Part 3」 。 <https://www.inquartik.com/blog/case-toshiba-memory-kioxia-patent-inventors/>
- [22] 「『キオクシア、活路は MRAM』 『ルネサスの GaN』 注目 5 本」 NIKKEI Tech Foresight、2024 年 12 月。 <https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC131LN0T11C24A2000000>
- [23] KIOXIA R&D 「Demonstration of Accelerated STT-Switching and High Retention in a 14nm MTJ towards High-Density STT-MRAM」 (IEDM 2023)。 <https://www.kioxia.com/en-jp/rd/technology/topics/topics-65.html>
- [24] KIOXIA 「Kioxia to Unveil Emerging Memory Technologies at IEDM 2024」 2024 年 10 月 21 日。 <https://apac.kioxia.com/en-apac/about/news/2024/20241021-1.html>
- [25] KIOXIA R&D 「64 Gbit クロスポイント MRAM における信頼性の高いセル動作」 (IEDM 2024 発表、ISSCC 2025 関連発表を含む R&D トピックス)。 <https://www.kioxia.com/ja-jp/rd/technology/topics/topics-80.html>
- [26] Dataintelo 「Embedded MRAM Market Research Report 2034」 。 <https://dataintelo.com/report/embedded-mram-market> ※市場推計値、機関により差異あり
- [27] SK hynix Inc. SEC Filing (Form F-1/A、FY2026):MonolithIC 3D による ITC 337 条調査(第 1・第 2)に関する開示。 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002120882/000119312526295501/d32785df1a.htm>
- [28] USITC 「USITC Institutes Section 337 Investigation of Certain NAND and DRAM Memory Chips」 (Inv. No. 337-TA-1492)2026 年 3 月 26 日。 [https://www.usitc.gov/press\\_room/news\\_release/2026/er0326\\_68355.htm](https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2026/er0326_68355.htm)
- [29] USITC 「USITC Institutes Section 337 Investigation of Certain NAND and DRAM Memory Chips and Products Containing the Same」 (第 2 調査、2026 年 5 月 11 日申立に基づく)2026 年 6 月 10 日。

[https://www.usitc.gov/press\\_room/news\\_release/2026/er0610\\_68723.htm](https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2026/er0610_68723.htm)

[30] China Intellectual Property Lawyers Network 「Chinese chipmaker YMTC sues Micron alleging patent infringement」 。 <https://www.ciplawyer.com/articles/151976.html> ※二次情報

注:URL は調査時点(2026 年 7 月 13 日)のもの。※印を付した文献は二次情報・第三者集計または推計値であり、一次情報での再確認を推奨する。本文中の(分析)(推測)表記は確認された事実と筆者分析の区別を示す。